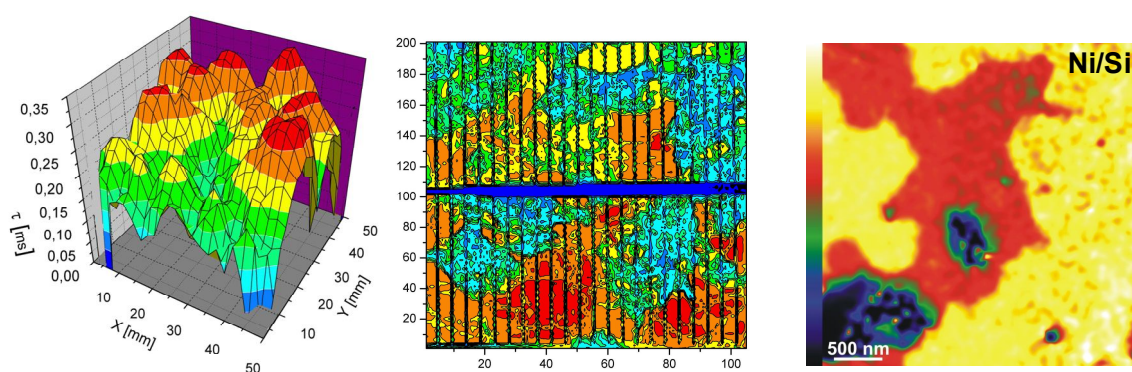


## Opracowane i opatentowane liczne metody charakteryzacji w celu diagnostyki i optymalizacji wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych

Ponad 20 opracowanych (w większości opatentowanych) metod charakteryzacji materiałów i przyrządów półprzewodnikowych w celu diagnostyki i optymalizacji ich wytwarzania, metod opartych na technikach mikroskopii elektronicznej, pomiarów fotoelektrycznych i pomiarów elektrycznych.



Rys. (od lewej do prawej) Trójwymiarowy rozkład i dwuwymiarowa mapa czasu życia nośników ładunku dla płytek krzemowych uzyskane metodą mikrofalowego pomiaru zaniku fotoprzewodności oraz mapa stosunku koncentracji Ni/Zr w kontakcie omowym do SiC, wyznaczona z pomiarów XEDS w TEM